

2SD852

**NPN エピタキシャル形シリコントランジスタ
(ダーリントン接続)
低速度大電流スイッチング用
工業用**

**NPN Silicon Epitaxial Transistor
(Darlington)
Low Speed High Current Switching
Industrial Use**

○ダーリントン接続であるため直流電流増幅率が高い。

High DC current gain.

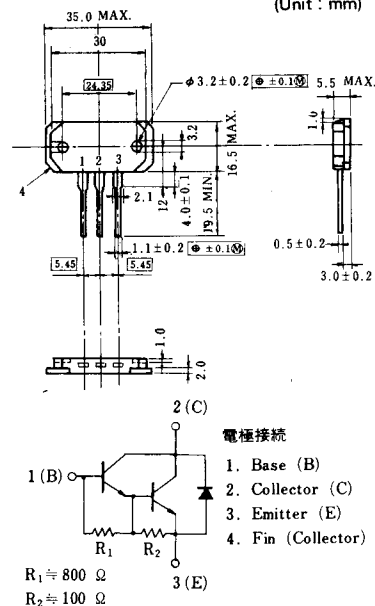
○コレクタ飽和電圧が低い。 Low collector saturation voltage.

○コンピュータ端末機器, パルスモータドライバ, リレードライバ等にICの出力から直接ドライブする用途に最適です。

Suitable for use in direct drive circuit from IC output such as terminal equipment pulse motor driver and relay driver applications.

外形図/PACKAGE DIMENSIONS

(Unit: mm)



絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25 °C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	8.0	V
コレクタ電流	I _{C(DC)}	±15	A
コレクタ電流	I _{C(pulse)*}	±30	A
ベース電流	I _{B(DC)}	1.5	A
全 損 失	P _T (T _a =25 °C)	3.0	W
全 損 失	P _T (T _c =25 °C)	100	W
ジャンクション温度	T _j	150	°C
保 存 温 度	T _{stg}	-55~+150	°C

*PW ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 10 %

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} =100 V, I _E =0			10	μA
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} =2.0 V, I _C =15 A *	1000	3000		
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =15 A, I _B =30 mA *		1.2	1.5	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C =15 A, I _B =30 mA *		1.8	2.2	V
ターンオン時間	t _{on}	I _C =15 A, I _{B1} =-I _{B2} =30 mA R _L =3.3 Ω, V _{CC} ≈50 V		1		μs
蓄 積 時 間	t _{stg}			5		μs
下 降 時 間	t _f			2		μs

*パルス測定 PW ≤ 350 μs, duty cycle ≤ 2 % / Pulsed